

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION  
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle  
Bureau international



(43) Date de la publication internationale  
13 juin 2002 (13.06.2002)

PCT

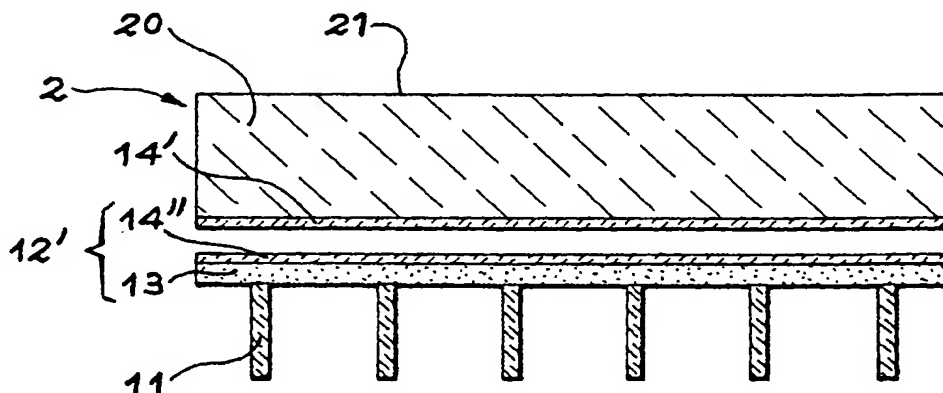
(10) Numéro de publication internationale  
WO 02/47156 A1

- (51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup> :  
H01L 21/762
- (21) Numéro de la demande internationale :  
PCT/FR01/03873
- (22) Date de dépôt international :  
7 décembre 2001 (07.12.2001)
- (25) Langue de dépôt : français
- (26) Langue de publication : français
- (30) Données relatives à la priorité :  
00/15980 8 décembre 2000 (08.12.2000) FR
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : COM-  
MISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR];  
31/33, rue de la Fédération, F-75752 Paris 15ème (FR).
- (72) Inventeurs; et  
(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : ASPAR,  
Bernard [FR/FR]; 110 Lotissement du Hameau des Ayes,  
F-38140 Rives (FR). BRUEL, Michel [FR/FR]; Presvert  
n°9, F-38113 Veurey-Voroize (FR).
- (74) Mandataire : LEHU, Jean; Brevatome, 3, rue du Docteur  
Lancereaux, F-75008 Paris (FR).
- (81) États désignés (national) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ,  
BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ,  
DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,  
HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK,  
LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,  
MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI,  
SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU,  
ZA, ZM, ZW.

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING A THIN FILM COMPRISING INTRODUCTION OF GASEOUS SPECIES

(54) Titre : PROCEDE DE REALISATION D'UNE COUCHE MINCE IMPLIQUANT L'INTRODUCTION D'ESPECES GA-  
ZEUSES



(57) Abstract: The invention concerns a method for producing a thin film from a structure, comprising the following steps: (a) producing a stacked structure consisting of a first part designed to facilitate introduction of gaseous species and a second part, the second part including a first free surface and a second surface integral with the first part; (b) introducing gaseous species in the structure, from the first part so as to produce a cleavage zone, the thin film being thus delimited between the first surface of the second part and said cleavage zone; (c) separating the thin film from the rest of the structure at the cleavage zone.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de réalisation d'une couche mince à partir d'une structure, comprenant les étapes suivantes (a) réalisation d'une structure empilée formée d'une première partie conçue pour faciliter l'introduction des espèces gazeuses et d'une deuxième partie, la deuxième partie possédant une première face libre et une deuxième face solidaire de la première partie, (b) introduction d'espèces gazeuses dans la structure, à partir de la première partie pour créer une zone fragilisée, la couche mince étant ainsi délimitée entre la première face de la deuxième partie et ladite zone fragilisée, (c) séparation de la couche mince du reste de la structure au niveau de la zone fragilisée.

WO 02/47156 A1



(84) États désignés (*régional*) : brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale

— avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

*En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.*

PROCÉDE DE REALISATION D'UNE COUCHE MINCE IMPLIQUANT  
L'INTRODUCTION D'ESPECES GAZEUSES

DESCRIPTION

5

Domaine technique

La présente invention concerne un procédé de réalisation d'une couche mince impliquant l'introduction d'espèces gazeuses. Elle permet en particulier de réaliser des couches d'épaisseur relativement fortes. Elle trouve des applications notamment dans le domaine des semi-conducteurs.

15 Etat de la technique antérieure

L'introduction d'espèces gazeuses dans un matériau solide peut être avantageusement réalisée par implantation ionique. Ainsi, le document FR-A-2 681 472 (correspondant au brevet américain N° 5 374 564) décrit un procédé de fabrication de films minces de matériau semiconducteur. Ce document divulgue que l'implantation d'un gaz rare et/ou d'hydrogène dans un substrat en matériau semiconducteur est susceptible d'induire, dans certaines conditions, la formation de microcavités ou de microbulles (encore désignées par le terme "platelets" dans la terminologie anglo-saxonne) à une profondeur voisine de la profondeur moyenne de pénétration des ions implantés. Si ce substrat est mis en contact intime, par sa face implantée avec un raidisseur et qu'un traitement thermique est appliqué à

une température suffisante, il se produit une interaction entre les microcavités ou les microbulles conduisant à une séparation du substrat semiconducteur en deux parties : un film mince semiconducteur adhérent  
5 au raidisseur d'une part, le reste du substrat semiconducteur d'autre part. La séparation a lieu au niveau de la zone où les microcavités ou microbulles sont présentes. Le traitement thermique est tel que l'interaction entre les microbulles ou microcavités  
10 créées par implantation est apte à induire une séparation entre le film mince et le reste du substrat. On peut donc obtenir le transfert d'un film mince depuis un substrat initial jusqu'à un raidisseur servant de support à ce film mince.

15 La création d'une zone fragilisée et la séparation au niveau de cette zone peuvent également être utilisées pour la fabrication d'un film mince de matériau solide autre qu'un matériau semiconducteur, un matériau conducteur ou diélectrique, cristallin ou non  
20 (voir le document FR-A-2 748 850).

Ce procédé s'avère très intéressant et est utilisé notamment pour obtenir des substrats SOI. Le passage de ces ions peut amener des perturbations pour certaines applications. Cependant, l'épaisseur de film  
25 mince obtenu dépend de l'énergie d'implantation que peut fournir les implantateurs. L'obtention de films relativement épais (50  $\mu\text{m}$  par exemple) exige des implantateurs très puissants, ce qui impose une limite pour les épaisseurs disponibles. Il peut en outre  
30 présenter un inconvénient en ce sens que le film mince

obtenu a été traversé par les ions destinés à former les microcavités.

Le document FR-A-2 738 671 (correspondant au brevet américain N° 5 714 395) divulgue un procédé  
5 utilisant également l'implantation ionique pour créer une zone fragilisée qui permet, grâce à un traitement postérieur, d'obtenir la séparation d'une couche superficielle d'avec le reste d'un substrat initial. Selon ce document, l'implantation ionique est effectuée  
10 à une profondeur supérieure ou égale à une profondeur minimum déterminée pour que le film mince obtenu soit rigide après sa séparation d'avec le reste du substrat initial. On entend par film rigide un film autoporté, c'est-à-dire indépendant mécaniquement et pouvant être  
15 utilisé ou manipulé directement.

#### Exposé de l'invention

Pour remédier à ces inconvénients, la  
20 présente invention propose d'implanter (ou d'introduire) les espèces gazeuses par la face arrière du substrat, c'est-à-dire par la face du substrat opposée au film ou couche mince désirée. Pour cela, il faut que le substrat soit "transparent aux ions" du  
25 côté de sa face arrière.

L'invention a donc pour objet un procédé de réalisation d'une couche mince à partir d'une structure, le procédé impliquant l'introduction d'espèces gazeuses pour créer une zone fragilisée  
30 conduisant à une séparation de la structure au niveau de cette zone fragilisée, le procédé étant caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

- a) réalisation d'une structure empilée formée d'une première partie conçue pour faciliter l'introduction des espèces gazeuses et d'une deuxième partie, la deuxième partie possédant une première face libre et  
5 une deuxième face solidaire de la première partie,  
b) introduction d'espèces gazeuses dans la structure, à partir de la première partie pour créer une zone fragilisée, la couche mince étant ainsi délimitée entre ladite première face libre de la deuxième  
10 partie et ladite zone fragilisée,  
c) séparation de la couche mince du reste de la structure au niveau de la zone fragilisée.

De préférence, l'introduction d'espèces gazeuses est réalisée par implantation ionique au  
15 travers de la face libre de la première partie.

L'introduction d'espèces gazeuses peut créer une zone fragilisée dans la première partie, dans la deuxième partie ou à l'interface entre la première partie et la deuxième partie.

20 La première partie peut comprendre un matériau à forte porosité ou à faible pouvoir d'arrêt pour les espèces gazeuses ou d'épaisseur correspondant à la profondeur de pénétration des espèces gazeuses dans cette première partie.

25 L'introduction d'espèces gazeuses étant réalisée par implantation ionique, la première partie peut comprendre un support transparent aux espèces gazeuses implantées, c'est-à-dire un support présentant des ouvertures aux espèces gazeuses implantées, le  
30 rapport de la surface totale des ouvertures par rapport à la surface du support étant tel que la séparation

peut se produire au niveau de la zone fragilisée créée. Le support peut être une grille, la première partie comprenant aussi un film déposé sur la grille et solidaire de la deuxième partie.

5           La première partie peut être un film autoporté initialement posé sur un support, la deuxième partie étant formée sur la première partie par croissance pour fournir une structure manipulable. La croissance de la deuxième partie peut être réalisée par  
10 un procédé de dépôt CVD ou un procédé d'épitanie en phase liquide.

Avantageusement, la première partie comprend une couche superficielle servant de germe pour la croissance de la deuxième partie sur la première  
15 partie. La croissance de la deuxième partie peut être réalisée par un procédé de dépôt CVD ou un procédé d'épitanie en phase liquide. L'introduction d'espèces gazeuses peut être menée de façon que la zone fragilisée laisse subsister, après séparation, en  
20 surface de la première partie une couche pouvant servir de germe pour faire croître à nouveau une deuxième partie sur la première partie.

Eventuellement, avant l'étape b) ou avant l'étape c), un support intermédiaire est fixé sur la  
25 première partie. Après l'étape c), le support intermédiaire peut être éliminé.

La structure peut comprendre une couche destinée à favoriser la séparation, les espèces gazeuses étant introduites dans cette couche.

L'étape de séparation peut être réalisée par apport d'énergie thermique et/ou mécanique à la zone fragilisée.

5 L'étape de séparation peut mettre en œuvre un apport d'énergie pour initier une action de clivage utilisant un front de clivage se propageant le long de la zone fragilisée. Cette technique est en particulier divulguée par le document WO 98/52 216.

10 Les espèces gazeuses peuvent être choisies parmi l'hydrogène et les gaz rares, ces espèces pouvant être introduites seules ou en combinaison.

#### Brève description des dessins

15 L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages et particularités apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre, donnée à titre d'exemple non limitatif, accompagnée des dessins annexés parmi lesquels :

- 20 - les figures 1A à 1D illustrent un premier mode de réalisation de la présente invention,  
- les figures 2A à 2D illustrent un deuxième mode de réalisation de la présente invention.

#### 25 Description détaillée de modes de réalisation de l'invention

Les figures 1A à 1D illustrent un mode de réalisation de l'invention où la première partie de la structure comprend une grille.

30 La figure 1A est une vue en perspective et en coupe partielle de cette première partie 10. La



première partie 10 comprend une grille 11 formée de barreaux dont la section peut être carrée ou rectangulaire. Les barreaux ont par exemple 80  $\mu\text{m}$  de largeur et peuvent être espacés de quelques centaines  
5 de micromètres à quelques millimètres. Suivant les dimensions des barreaux et des espacements qui les séparent, la grille peut servir de raidisseur et permettre la séparation au niveau de la zone implantée sans induire la formation de cloques.

10 Quand les espacements entre les barreaux sont trop grands et/ou si la profondeur de pénétration des ions n'est pas suffisante pour induire une séparation (on a alors formation de cloques) et conduire à un film autoporté, on peut déposer après  
15 l'étape d'implantation une couche qui sert de raidisseur sur la face libre de la première partie.

La grille 11 peut être réalisée par gravure d'une plaquette de Si ou de SiC.

La grille 11 sert de support à un film 12  
20 formé d'une ou plusieurs couches, par exemple de deux couches 13 et 14. Si on désire obtenir à l'issue du procédé une couche mince de silicium monocristallin, la couche 13 peut être en  $\text{SiO}_2$  et avoir 1  $\mu\text{m}$  d'épaisseur et la couche 14 peut être en silicium et avoir 2  $\mu\text{m}$   
25 d'épaisseur. Le film 12 peut être obtenu et déposé sur la grille 11 par le procédé divulgué dans le document FR-A-2 738 671 cité plus haut. Le film 12 peut être rendu solidaire de la grille 11 par une technique d'adhésion moléculaire connue de l'homme de l'art. On  
30 peut aussi utiliser une colle pour solidariser le film

12 et la grille 11 en s'assurant que la colle ne perturbe pas l'implantation ionique.

La couche 14 peut alors servir à la formation de la deuxième partie de la structure. C'est ce que montre la figure 1B qui est une vue en coupe transversale de la structure. La deuxième partie 20 est une couche de silicium monocristallin obtenue par croissance à partir de la couche 14 servant de germe. La croissance est par exemple obtenue par une technique de dépôt CVD ou par épitaxie en phase liquide. La deuxième partie 20 peut alors atteindre plusieurs  $\mu\text{m}$ , voire quelques dizaines de  $\mu\text{m}$ , par exemple 50  $\mu\text{m}$  d'épaisseur.

La figure 1C, qui est également une vue en coupe transversale de la structure, illustre l'étape d'implantation ionique effectuée au travers de la grille 11. L'implantation ionique peut consister à implanter des ions hydrogène, figurés symboliquement par les flèches 1, avec une dose de  $10^{17}\text{H}^+/\text{cm}^2$  et une énergie de 400 keV. Les ions parviennent majoritairement dans la couche 14 en silicium pour y former une zone fragilisée 15.

L'introduction d'espèces gazeuses dans une couche de matériau pour constituer une zone fragilisée peut aussi se faire par d'autres méthodes employées seules ou en combinaison et décrites dans le document FR-A-2 773 261.

La figure 1D, qui est également une vue en coupe transversale de la structure, illustre l'étape de séparation. La séparation peut avoir lieu par recuit thermique et/ou par utilisation de forces mécaniques.

On obtient alors une couche mince 2 entre la face libre 21 de la deuxième partie 20 et l'emplacement initial de la zone fragilisée. La couche initiale 14 est alors scindée en deux sous-couches 14' et 14". La couche 5 mince 2, d'environ 50  $\mu\text{m}$  d'épaisseur, est récupérée pour être exploitée. Le reste de la structure, constitué de l'empilement grille 11, couche 13 et sous-couche 14" (formant le film 12'), peut être réutilisé comme nouvelle première partie, la sous-couche 14" 10 servant de germe pour la formation d'une nouvelle seconde partie.

Dans cet exemple de réalisation, la zone fragilisée a été créée dans la couche 14 appartenant à la première partie de la structure, la couche mince 15 obtenue comprenant alors la première partie de la structure et une portion de la deuxième partie (la sous-couche 14'). Il entre aussi dans le cadre de la présente invention de créer la zone fragilisée à l'interface des deux parties, auquel cas la couche 20 mince obtenue correspondrait exactement à la deuxième partie de la structure. Cette variante présente un avantage : une zone de défauts créée à cette interface favorise la séparation. Cette zone de défauts peut contenir des défauts cristallins et/ou des microcavités 25 qui vont favoriser la séparation. Il est aussi possible de créer la zone fragilisée dans la deuxième partie de la structure, auquel cas la couche mince obtenue correspondrait à une portion de la deuxième partie.

Dans une variante du procédé, 30 l'introduction des espèces gazeuses peut être réalisée pour une énergie d'implantation de 200 keV par exemple.

Dans ce cas, avant séparation on rajoute sur la face libre de la première partie une couche qui sert de raidisseur et qui permet la séparation. Cette couche peut être constituée par exemple de 3  $\mu\text{m}$  d'oxyde de silicium.

La deuxième partie de la structure peut aussi être constituée d'un empilement de couches. Elle peut-être, temporairement ou non, fixée à un support intermédiaire.

Il peut être prévu dans la structure une couche spécifique, par exemple réalisée avant la formation de la deuxième partie, destinée à favoriser la séparation au niveau de la zone fragilisée. La couche spécifique peut être une couche de SiGe épitaxiée sur une couche de silicium de la première partie. La deuxième partie est épitaxiée sur la couche de SiGe et l'implantation est réalisée au niveau de la couche de SiGe contrainte. La couche spécifiée peut être une couche de silicium fortement dopée au bore. Un tel matériau permet d'obtenir une séparation à l'aide d'un budget thermique et/ou mécanique plus faible.

Les figures 2A à 2D illustrent un autre mode de réalisation de l'invention où la première partie de la structure est constituée par un film autoporté. Ces figures sont des vues en coupe transversale.

La figure 2A montre un film autoporté 31 posé sur un support 30 sans y adhérer. Le film autoporté 31 est par exemple un film de silicium de 5  $\mu\text{m}$  d'épaisseur obtenu par le procédé divulgué dans le

document FR-A-2 738 671 cité plus haut. Ce film 31 constitue la première partie de la structure.

La figure 2B montre qu'une couche 32 a été formée sur le film 31. La couche 32 peut être une  
5 couche de silicium de 45  $\mu\text{m}$  d'épaisseur, épitaxiée sur la couche 31. La couche 32 constitue la deuxième partie de la structure. On obtient une structure manipulable.

La figure 2C montre la structure qui a été retournée sur son support 30 pour subir l'étape  
10 d'implantation ionique. Des ions hydrogène (figurés symboliquement par les flèches 33) sont alors implantés, par exemple pour une dose de  $10^{17}\text{H}^+/\text{cm}^2$  et avec une énergie de 500 keV. Dans cet exemple de réalisation, la zone fragilisée est créée à l'interface  
15 entre les deux parties 31 et 32. Pour créer cette zone fragilisée, on peut utiliser une coimplantation d'hélium et d'hydrogène par exemple.

La structure est à nouveau retournée sur son support et, par exemple par un traitement thermique  
20 ou par un traitement thermique partiel suivi d'une application de forces mécaniques, la séparation entre les parties 31 et 32 est obtenue. On obtient une couche mince constituée par la deuxième partie 32 comme le montre la figure 2D. La partie 31 peut à nouveau être  
25 utilisée pour appliquer le procédé de l'invention.

L'invention s'applique à l'obtention de couches minces de différents matériaux. Il est ainsi possible d'obtenir des couches de GaN autoportées pour des applications optoélectroniques ou microélectro-  
30 niques. Dans ce cas, le film autoporté peut être en SiC. Sur ce film, on peut réaliser une couche épaisse

de GaN par exemple par épitaxie à 1050°C. De l'hydrogène est ensuite implanté selon une dose de  $10^{16} \text{H}^+/\text{cm}^2$  à 250 keV dans le SiC au voisinage de l'interface avec GaN. A l'aide par exemple d'un  
5 traitement thermique à 850°C, la séparation est obtenue au niveau de la zone implantée. On obtient un film de GaN autoporté muni d'une couche mince de SiC provenant de la séparation. Le reste du film de SiC qui est toujours autoporté peut être recyclé.

## REVENDICATIONS

1. Procédé de réalisation d'une couche mince (2,32) à partir d'une structure, le procédé
- 5 impliquant l'introduction d'espèces gazeuses pour créer une zone fragilisée conduisant à une séparation de la structure au niveau de cette zone fragilisée, le procédé étant caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :
- 10 a) réalisation d'une structure empilée formée d'une première partie (10,31) conçue pour faciliter l'introduction des espèces gazeuses et d'une deuxième partie (20,32) la deuxième partie possédant une première face libre et une deuxième face solidaire de
- 15 la première partie,
- b) introduction d'espèces gazeuses dans la structure, à partir de la première partie (10,31) pour créer une zone fragilisée (15), la couche mince étant ainsi délimitée entre ladite première face libre de la
- 20 deuxième partie et ladite zone fragilisée,
- c) séparation de la couche mince (2,32) du reste de la structure au niveau de la zone fragilisée.
2. Procédé selon la revendication 1,
- 25 caractérisé en ce que l'introduction d'espèces gazeuses est réalisée par implantation ionique au travers de la face libre de la première partie.
3. Procédé selon la revendication 1,
- 30 caractérisé en ce que l'introduction d'espèces gazeuses

crée une zone fragilisée (15) dans la première partie (10).

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'introduction d'espèces gazeuses crée une zone fragilisée dans la deuxième partie.

5. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'introduction d'espèces gazeuses crée une zone fragilisée à l'interface entre la première partie (31) et la deuxième partie (32).

6. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première partie comprend un matériau à forte porosité ou à faible pouvoir d'arrêt pour les espèces gazeuses ou d'épaisseur correspondant à la profondeur de pénétration des espèces gazeuses dans cette première partie.

7. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que la première partie comprend un support transparent aux espèces gazeuses implantées, c'est-à-dire un support présentant des ouvertures aux espèces gazeuses implantées, le rapport de la surface totale des ouvertures par rapport à la surface du support étant tel que la séparation peut se produire au niveau de la zone fragilisée créée.

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que le support est une grille (11), la première partie (10) comprenant aussi un film (12)



déposé sur la grille et solidaire de la deuxième partie (20).

9. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première partie (31) est un film autoporté initialement posé sur un support (30), la deuxième partie étant formée sur la première partie par croissance pour fournir une structure manipulable.

10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce que la croissance de la deuxième partie (32) est réalisée par un procédé de dépôt CVD ou un procédé d'épitanie en phase liquide.

11. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première partie (10) comprend une couche superficielle (14,14") servant de germe pour la croissance de la deuxième partie sur la première partie.

12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce que la croissance de la deuxième partie est réalisée par un procédé de dépôt CVD ou un procédé d'épitanie en phase liquide.

13. Procédé selon l'une des revendications 11 ou 12, caractérisé en ce que l'introduction d'espèces gazeuses est menée de façon que la zone fragilisée (15) laisse subsister, après séparation, en surface de la première partie (10) une couche (14")

pouvant servir de germe pour faire croître à nouveau une deuxième partie sur la première partie.

14. Procédé selon la revendication 1,  
5 caractérisé en ce que, avant l'étape b) ou avant l'étape c), un support intermédiaire est fixé sur la première partie.

15. Procédé selon la revendication 14,  
10 caractérisé en ce que, après l'étape c), le support intermédiaire est éliminé.

16. Procédé selon la revendication 1,  
caractérisé en ce que la structure comprend une couche  
15 destinée à favoriser la séparation, les espèces gazeuses étant introduites dans cette couche.

17. Procédé selon la revendication 1,  
caractérisé en ce que l'étape de séparation est  
20 réalisée par apport d'énergie thermique et/ou mécanique à la zone fragilisée.

18. Procédé selon la revendication 1,  
caractérisé en ce que l'étape de séparation met en  
25 œuvre un apport d'énergie pour initier une action de clivage utilisant un front de clivage se propageant le long de la zone fragilisée.

19. Procédé selon la revendication 1,  
30 caractérisé en ce que les espèces gazeuses sont

choisies parmi l'hydrogène et les gaz rares, ces espèces étant introduites seules ou en combinaison.

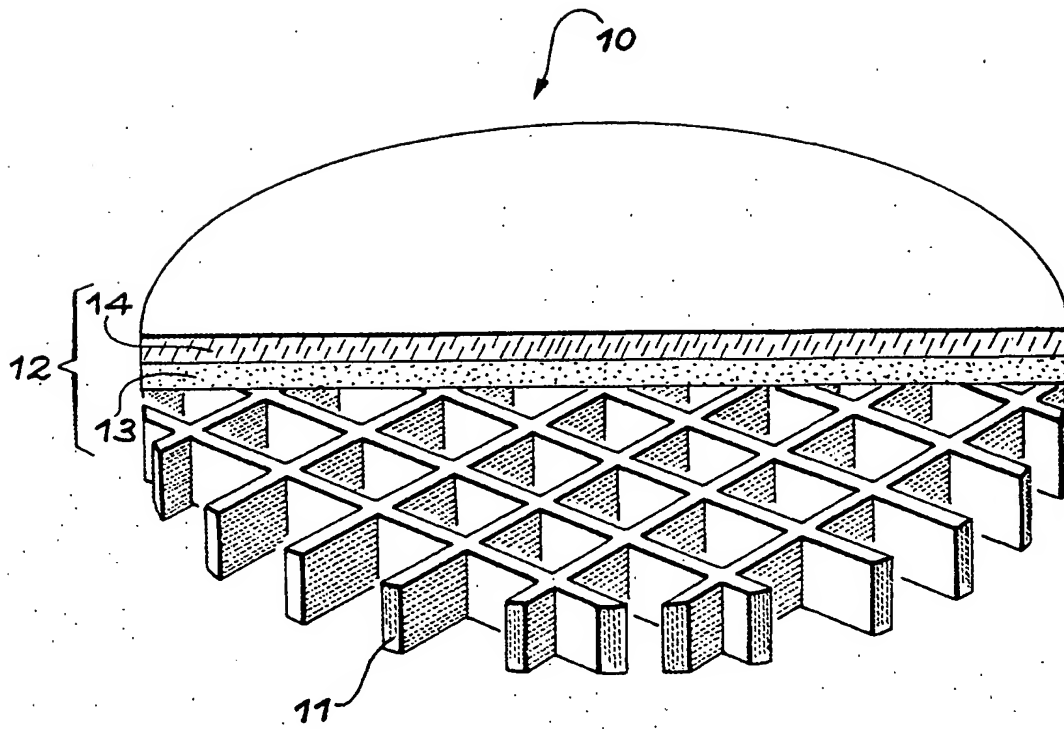


FIG. 1A

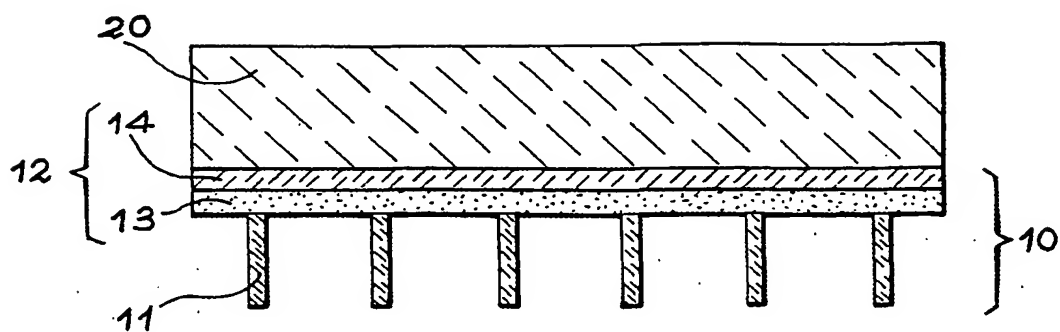


FIG. 1B

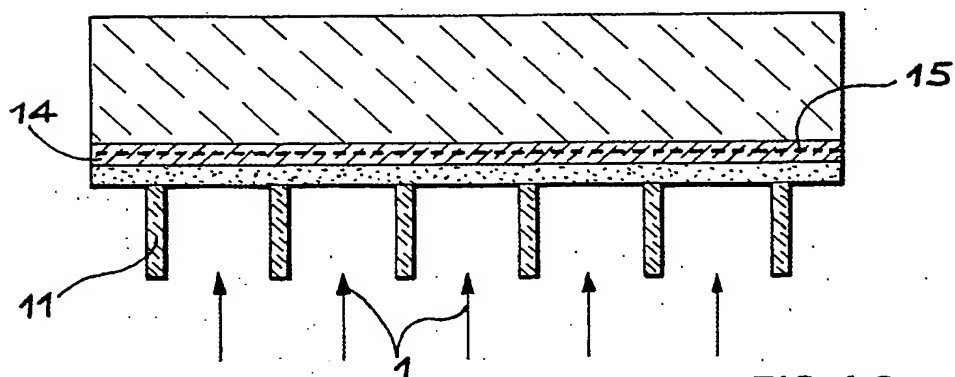


FIG. 1C

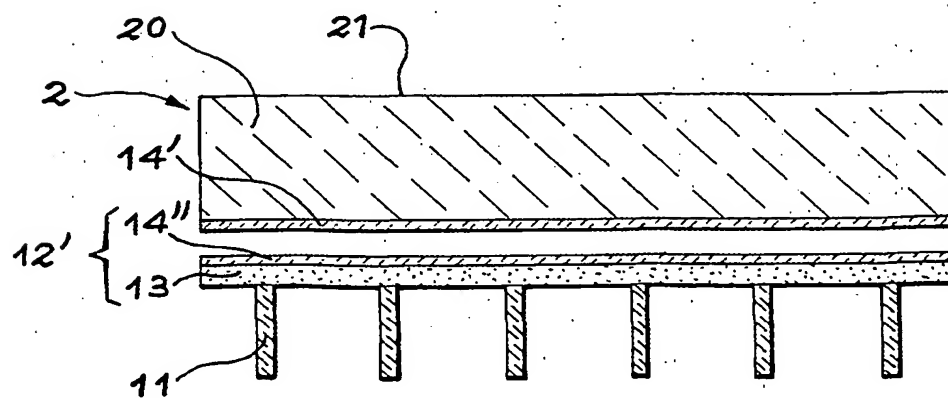


FIG. 1D

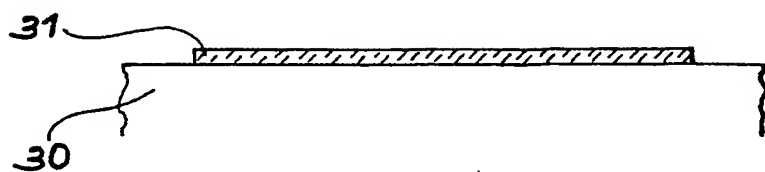


FIG. 2A

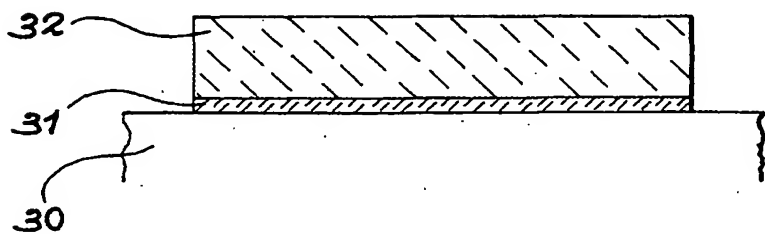


FIG. 2B

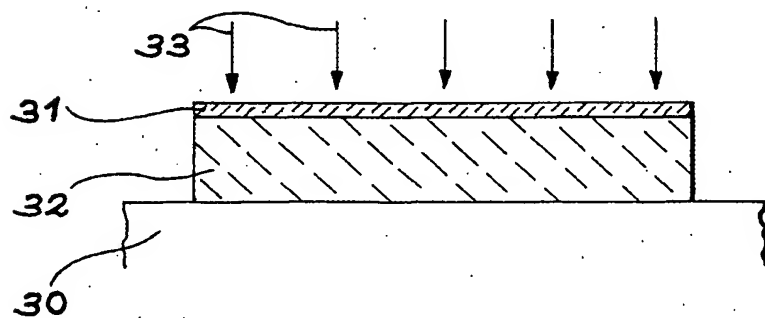


FIG. 2C

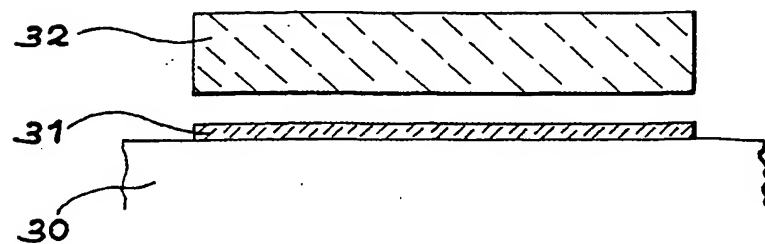


FIG. 2D

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 01/03873

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
IPC 7 H01L21/762

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, INSPEC, IBM-TDB

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 10, 31 August 1999 (1999-08-31) & JP 11 126910 A (DENSO CORP), 11 May 1999 (1999-05-11) -& US 6 191 007 B1 (OHSHIMA HISAYOSHI ET AL) 20 February 2001 (2001-02-20) column 34, line 56 -column 35, line 28; figure 22 ---	1-3, 17-19
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 02, 26 February 1999 (1999-02-26) -& JP 10 308355 A (DENSO CORP), 17 November 1998 (1998-11-17) abstract; figures --- -/--	1-5,9-13

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

## \* Special categories of cited documents :

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*&\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

25 March 2002

Date of mailing of the international search report

12/04/2002

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Wirner, C

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 01/03873

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 767 486 A (CANON KK) 9 April 1997 (1997-04-09) abstract; claims; figures ----	1-7, 16-19
A	"SOI INTERPOSER STRUCTURE" IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, IBM CORP. NEW YORK, US, vol. 39, no. 7, 1 July 1996 (1996-07-01), pages 191-195, XP000627972 ISSN: 0018-8689 abstract; figures ----	1,14,15
A	EP 0 763 849 A (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE) 19 March 1997 (1997-03-19) cited in the application abstract; claims; figures ----	1,14,15
A	EP 0 665 588 A (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE) 2 August 1995 (1995-08-02) abstract; claims; figures -----	1,7,8



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR 01/03873

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
JP 11126910	A	11-05-1999	US 6191007 B1	20-02-2001
JP 10308355	A	17-11-1998	US 6251754 B1	26-06-2001
EP 0767486	A	09-04-1997	JP 9162090 A	20-06-1997
			CA 2187269 A1	07-04-1997
			CN 1159071 A	10-09-1997
			EP 0767486 A2	09-04-1997
			SG 63669 A1	30-03-1999
			US 6246068 B1	12-06-2001
			US 5854123 A	29-12-1998
			US 2001019153 A1	06-09-2001
EP 0763849	A	19-03-1997	FR 2738671 A1	14-03-1997
			DE 69617147 D1	03-01-2002
			EP 0763849 A1	19-03-1997
			JP 9181011 A	11-07-1997
			US 5714395 A	03-02-1998
EP 0665588	A	02-08-1995	FR 2715501 A1	28-07-1995
			DE 69508817 D1	12-05-1999
			DE 69508817 T2	07-10-1999
			EP 0665588 A1	02-08-1995
			JP 7254690 A	03-10-1995
			US 5559043 A	24-09-1996

## RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No

PCT/FR 01/03873

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE  
CIB 7 H01L21/762

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

## B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 H01L

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, INSPEC, IBM-TDB

## C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 10, 31 août 1999 (1999-08-31) & JP 11 126910 A (DENSO CORP), 11 mai 1999 (1999-05-11) -& US 6 191 007 B1 (OHSHIMA HISAYOSHI ET AL) 20 février 2001 (2001-02-20) colonne 34, ligne 56 -colonne 35, ligne 28; figure 22	1-3, 17-19
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 02, 26 février 1999 (1999-02-26) -& JP 10 308355 A (DENSO CORP), 17 novembre 1998 (1998-11-17) abrégé; figures	1-5,9-13

-/--

☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

## \* Catégories spéciales de documents cités:

- \*A\* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- \*E\* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- \*L\* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- \*O\* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- \*P\* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

\*T\* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

\*X\* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

\*Y\* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

\*Z\* document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

25 mars 2002

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

12/04/2002

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Werner, C

## RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No

PCT/FR 01/03873

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	EP 0 767 486 A (CANON KK) 9 avril 1997 (1997-04-09) abrégé; revendications; figures ----	1-7, 16-19
A	"SOI INTERPOSER STRUCTURE" IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, IBM CORP. NEW YORK, US, vol. 39, no. 7, 1 juillet 1996 (1996-07-01), pages 191-195, XP000627972 ISSN: 0018-8689 abrégé; figures ----	1, 14, 15
A	EP 0 763 849 A (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE) 19 mars 1997 (1997-03-19) cité dans la demande abrégé; revendications; figures ----	1, 14, 15
A	EP 0 665 588 A (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE) 2 août 1995 (1995-08-02) abrégé; revendications; figures -----	1, 7, 8

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande Internationale No

PCT/FR 01/03873

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
JP 11126910	A	11-05-1999	US 6191007 B1	20-02-2001
JP 10308355	A	17-11-1998	US 6251754 B1	26-06-2001
EP 0767486	A	09-04-1997	JP 9162090 A	20-06-1997
			CA 2187269 A1	07-04-1997
			CN 1159071 A	10-09-1997
			EP 0767486 A2	09-04-1997
			SG 63669 A1	30-03-1999
			US 6246068 B1	12-06-2001
			US 5854123 A	29-12-1998
			US 2001019153 A1	06-09-2001
EP 0763849	A	19-03-1997	FR 2738671 A1	14-03-1997
			DE 69617147 D1	03-01-2002
			EP 0763849 A1	19-03-1997
			JP 9181011 A	11-07-1997
			US 5714395 A	03-02-1998
EP 0665588	A	02-08-1995	FR 2715501 A1	28-07-1995
			DE 69508817 D1	12-05-1999
			DE 69508817 T2	07-10-1999
			EP 0665588 A1	02-08-1995
			JP 7254690 A	03-10-1995
			US 5559043 A	24-09-1996